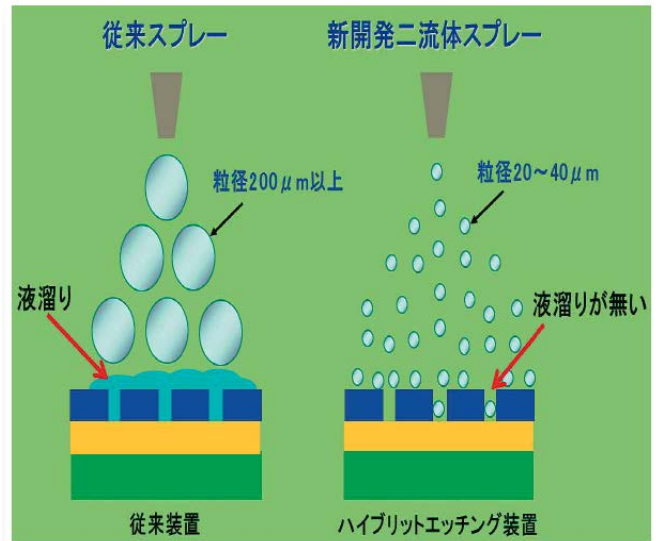
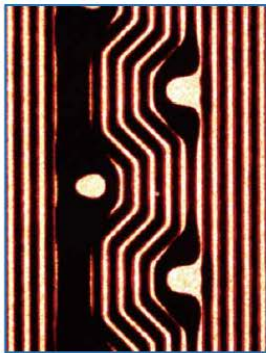


# ハイブリッドエッチング装置

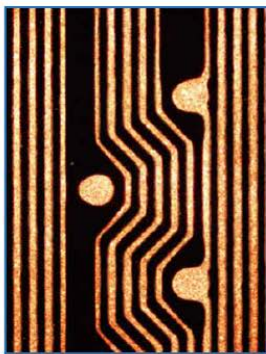
(特許取得済)



回路表面

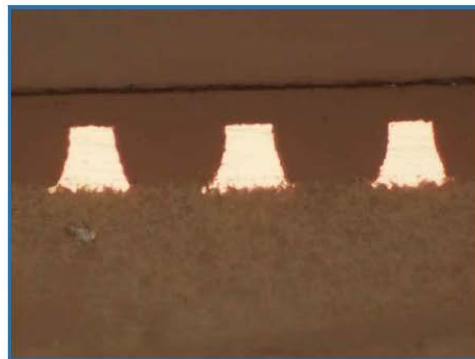


エミネントタイプ



ハイブリッドエッチング

回路断面



L/S=15/15 $\mu$ m

Top	9.7 $\mu$ m
Bottom	16.7 $\mu$ m
Thickness	12.4 $\mu$ m
E F	3.5



L/S=15/15 $\mu$ m

Top	9.4 $\mu$ m
Bottom	14.5 $\mu$ m
Thickness	12.5 $\mu$ m
E F	8.1